### Exercice 1

## Réponse :

1)

Maille d'entrée :  $V_{BE} + R_BI_B = V_{CC}$ 

On a  $I_B = I_C / \beta = 1 \text{ mA}$ 

Donc 
$$R_B = (V_{CC} - V_{BE})/I_B = (12 - 0.7)/1 (K\Omega)$$

Finalement on doit prendre  $R_B = 11,3 \text{ K}\Omega$  pour obtenir un courant de 100mA dans la résistance  $R_L$ .

2)

 $I_C$  est maximal lorsque  $I_C = V_{CC}/R_C$ .

Donc  $I_C = 12/60 = 0.2$  A soit 200 mA.

Le transistor est saturé donc lorsque IC atteint la valeur 200 mA

3) pour avoir I = Isat = 200 mA il faut avoir IBsat = ICsat /  $\beta$  = 200/100 = 2mA

Il faut donc  $R_{Bsat} = (V_{CC} - V_{BE})/I_{Bsat} = (12-0,7)/2 = 5,65 \text{ K}\Omega$ 

Pour saturer le transistor  $I_B$  doit être > 2 mA et donc  $R_B$  < 5,65 K $\Omega$ 

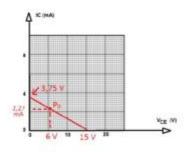
3)

Si on diminue R<sub>B</sub> I<sub>B</sub> augmente et aussi I<sub>C</sub> mais lorsque R<sub>B</sub> devient inférieure à 5,65 IB devient supérieure à 2 mA mais IC ne peut plus suivre cette augmentation et se sature à 200mA.

## **Exercice 2**

$$V_{BE} + R_{B} = V_{CC} - V_{BE} = V_{CC} - V_$$

### **Exercice 3**



$$V_C = V_{CC} - R_C I_C \ 15 - 2.2,27 = 10,46 \ V$$
 
$$V_B = VCC - RBIB = 15 - 430 \ . \ (2,27/100) = 12,73 \ V$$
 
$$VE = VB - 0,7 = 12 \ V$$

# **Exercice 4**

